
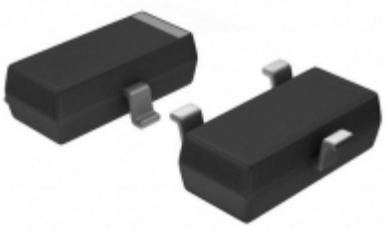
	<p>SI2308DS-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2308DS-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 2A SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  SI2308DS-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 75011 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2308DS-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 2A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	75011 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 1.25W (Ta) Surface Mount SOT-23-3
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	240pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2308DS-T1-E3CT

SI2308DS-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI2308DS-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2308DS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2308DS-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2308CDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 2.6A SOT23-3</p>	 <p>SI2309BDS-T1-E3 V SI2309BDS-T1-E3 V</p>	 <p>SI2309 KF SI2309 KF</p>	 <p>SI2308DS-T1 VISHAY SI2308DS-T1 VISHAY</p>
 <p>SI2308DS VISHAY SI2308DS VISHAY</p>	 <p>SI2308BDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 2.3A SOT23-3</p>	 <p>SI2308DS-T1-GE3 VISHAY SI2308DS-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI2308DS-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 2A SOT23-3</p>

heiße Teile

Mehr

SI2306DS-T1-E3	SI2306DS-T1-GE3	SI2306WCA	SI2307BDS	SI2307BDS-T1-E3
SI2307BDS-T1-E3	SI2307BDS-T1-GE3	SI2307BDS-T1-GE3	SI2307CDS	SI2307CDS-T1-E3
SI2307CDS-T1-E3	SI2307CDS-T1-GE3	SI2307CDS-T1-GE3	SI2307DS	SI2307DS-T1
SI2307DS-T1-E3	SI2307DS-T1-GE3	SI2307DS-T7-E3	SI2308BDS	SI2308BDS-T1-E3
SI2308BDS-T1-E3	SI2308BDS-T1-GE3	SI2308BDS-T1-GE3	SI2308DS	SI2308DS-T1
SI2308DS-T1-E3	SI2308DS-T1-GE3	SI2309BDS-T1-E3	SI2309BDS-T1-GE3	SI2309CDS-T1-GE3
SI2309CDS-T1-GE3	SI2309DS	SI2309DS-T1	SI2309DS-T1-E3	SI2309DS-T1-E3
SI2309DS-T1-GE3	SI2309DS-T1-E3	SI2309DS/A92T	SI2310DS	SI2310DS-T1-E3
SI2310DS-T1-GE3	SI2311DS	SI2311DS-T1	SI2311DS-T1-E3	SI2311DS-T1-E3
SI2311DS-T1-GE3	SI2311DS-T1-GE3	SI2312BDS	SI2312BDS-T1-E3	SI2312BDS-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited